

東芝シリコンエピタキシャルプレーナトランジスタ

2SC370, 2SC371, 2SC372, 2SC373, 2SC374

Toshiba Silicon Epitaxial Planar Transistor

東芝 2SC370~2SC374 はシリコン NPN エピタキシャルプレーナ形トランジスタで低レベルにおける特性がすぐれており、低周波から高周波までの広い範囲の増幅回路に使用でき、安定な特性が得られる。

最大定格 (周囲温度 25°C)

コレクタベース間電圧	V_{CBO}	最大	35 V
コレクタエミッタ間電圧	V_{CEO}	最大	30 V
エミッタベース間電圧	V_{EBO}	最大	4 V
コレクタ電流	I_C	最大	100 mA
エミッタ電流	I_E	最大	-100 mA
コレクタ許容損失	P_C	最大	200 mW
周囲温度 保存時	T_{stg}	最大	-55°C
		最大	125°C
接合部温度	T_j	最大	125°C

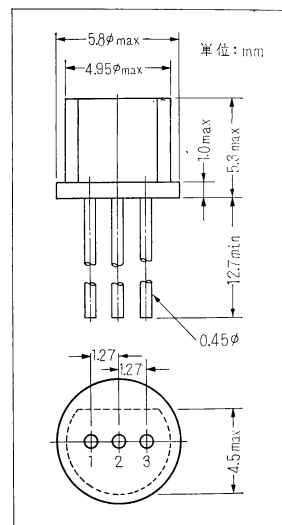
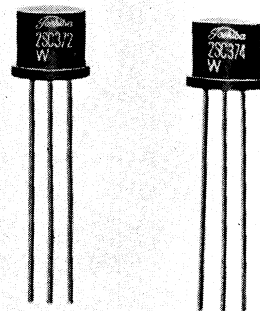
電気的特性 (周囲温度 25°C)

	最小値	標準値	最大値
コレクタシャ断電流 ($V_{CB}=18\text{ V}$, $I_E=0$)	I_{CBO}		0.5 μA
エミッタシャ断電流 ($V_{EB}=2\text{ V}$, $I_C=0$)	I_{EBO}		1.0 μA

直流電流増幅率 ($V_{CE}=12\text{ V}$, $I_C=2\text{ mA}$)	最小値	標準値	最大値
h_{FE}			
2SC370	20		60
2SC371	40		160
2SC372	70		280
2SC373	150		500
2SC374	280		1,000

コレクタ出力容量 ($V_{CB}=10\text{ V}$, $I_E=0$)	Cob	3.5 pF
--	-----	--------

トランジション周波数 ($V_{CE}=10\text{ V}$, $I_E=-1\text{ mA}$)	f_T	80 Mc
---	-------	-------



電極接続
1. エミッタ 2. コレクタ 3. ベース
外形図

